

[11] Utility Model Unexamined Publication No. S64-45760

[21] Application number: S62-140779

[22] Date of Filing: September 14, 1987

[43] Date of publication of application: March 20, 1989

[51] Int.Cl.<sup>4</sup>:

C 23 C 14/22

H 01 L 21/205

21/208

21/68

[54] Title of the Invention: Vacuum Deposition Equipment

[71] Applicant: NEC Corporation

[72] Inventor(s): Fumiaki Kitano

[57] What is claimed is:

Vacuum deposition equipment such as sputtering equipment and plasma CVD equipment, the vacuum deposition equipment comprising a laminated member made by laminating plurality of thin metal sheets of 20 to 50  $\mu$ , the laminated member being easily detachable and being disposed on one of a shielding sheet and a depositing substrate support provided inside the equipment.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a sectional view illustrating an internal structure of sputtering equipment in accordance with a first exemplary embodiment of the present invention, and Fig. 2 is a sectional view of a second exemplary embodiment of the present invention.

- |      |  |
|------|--|
| 1    | Depositing substrate                   |
| 2    | Depositing substrate support           |
| 3, 6 | Thin stainless steel sheet member      |
| 4    | Al target for sputtering               |
| 5    | Shielding sheet                        |
| 7    | SiO <sub>2</sub> target for sputtering |

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭64-45760

⑮ Int. Cl.<sup>4</sup>

C 23 C 14/22  
H 01 L 21/205  
21/208  
21/68

識別記号

庁内整理番号

8520-4K  
7739-5F  
7630-5F  
N-7454-5F

⑯ 公開 昭和64年(1989)3月20日

審査請求 未請求 (全1頁)

⑰ 考案の名称 真空被着装置

⑱ 実 願 昭62-140779

⑲ 出 願 昭62(1987)9月14日

⑳ 考 案 者 北 野 文 紹 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

㉑ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

㉒ 代 理 人 弁理士 菅 野 中

㉓ 実用新案登録請求の範囲

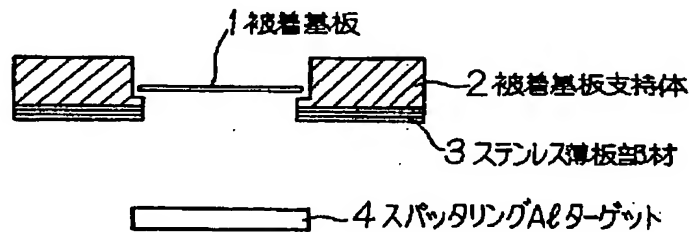
スパッタリング装置、プラズマCVD装置等の真空被着装置において、装置内部に設けたシールド板或いは被着基板支持体に、容易に脱着可能な20~50 $\mu$ の金属薄板を複数枚重ねた部材を設置したことを特徴とする真空被着装置。

図面の簡単な説明

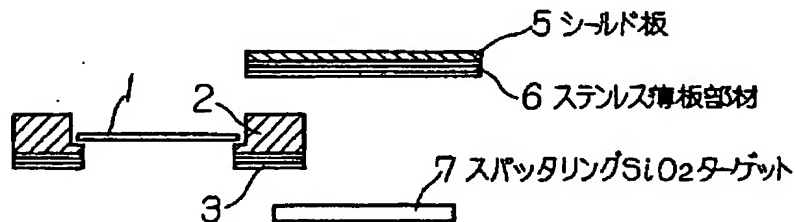
第1図は本考案の実施例1のスパッタリング装

置の内部構造体の断面図、第2図は本考案の実施例2の断面図である。

1……被着基板、2……被着基板支持体、3、6……ステンレス薄板部材、4……スパッタリング用Alターゲット、5……シールド板、7……スパッタリング用SiO<sub>2</sub>ターゲット。



第1図



第2図